## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-240798

(43)Date of publication of application: 04.09,2001

(51)Int.CI.

C09D183/00 CO8G 77/08 CO8G 77/50 C08K COSK CO8L C08L CO9D

(21)Application number: 2000-052017

(22)Date of filing:

28.02,2000

(71)Applicant:

**JSR CORP** 

(72)Inventor:

HAYASHI EIJI JO YOSHIHIDE HASEGAWA KOICHI SHIODA ATSUSHI YAMADA KINJI

(54) FILM-FORMING COMPOSITION AND ELECTRICAL FILM-FORMING MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a film-forming composition yielding a coated film which has a uniform thickness and has an excellent mechanical strength, crack resistance and CMP resistance and a low dielectric constant. SOLUTION: The film-forming composition contains (A); a hydrolysate and/or condensate of at least one compound chosen from the group of R1aSi(OR2)4-a, wherein R1 is hydrogen, fluorine or a monovalent organic group; R2 is a monovalent organic group; and a is an integer of 0-2) and R3b(R4O)3-bSi-(R7)d-Si(OR5)3-cR6c wherein R3, R4, R5 and R6 are each a monovalent organic group; b and c are each 0-2; R7 is oxygen or a-(CH2)ngroup; n is 1-6; and d is 0 or 1 and (B); HO-(SiR8R90)eH wherein R8 and R9 are each a monovalent organic group; and e is an integer of 2-100.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公別番号 特開2001-240798 (P2001-240798A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成13年9月4日(2001.9.4)

(51) Int CL'	識別記号	FI	•	テーマエード( <del>参考</del> )
C09D 183	3/00	C 0 9 D 18	33/00	45002
C08G 77	/08	C08G 7	77/08	4 J 0 3 5
77	/50	7	77/50	4 J 0 3 8
C08K 5	/00	C08K	5/00	5 F 0 3 3
5	/07		5/07	5F058
	•	等空間求 未請求 請求明	質の数5 OL	(全 14 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特勵2000-52017(P2000-52017)	(71)出頭人	000004178	
			ジェイエスアール株式会社	
(22)出顧日	平成12年2月28日(2000.2.28)		東京都中央区築地2丁目11番24号	
		(72)発明者	林 英治	
			東京都中央区築地二丁目11番24号 ジ	゛ェイ
		ŀ	エスアール株式会社内	
		(72)発明者	徐 荣秀	
	<i>1</i>		東京都中央区築地二丁目11番24号 ジ	ェイ
	•		エスアール株式会社内	
		(72) 発明者	長谷川 公一	
			東京都中央区築地二丁目11番24号 ジ	エイ
•			エスアール株式会社内	

## (54) 【発明の名称】 膜形成用組成物および絶縁膜形成用材料

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 均一な厚さで、塗膜の機械的強度やクラック 耐性やCMP耐性に優れ、かつ低比誘電率の塗膜が得ら れる膜形成用組成物を得る。

【特許請求の範囲】

(A) (A-1) 下記一般式(1) で表 【請求項1】 される化合物

 $R^{l_a}Si(OR^2) \leftarrow \cdots (1)$ 

R36 (R40) 36 Si-(R7) 4-Si (OR5) 3-c R6c  $\cdots (2)$ 

(R³, R¹, R⁵およびR°は、同一でも異なっていても よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同 一でも異なっていてもよく、0~2の数を示し、R<sup>7</sup>は 酸素原子またはー  $(CH_2)$ 。一で表される基を示し、nは1~6を、dは0または1を示す。) からなる群より 選ばれる少なくとも1種の化合物の加水分解物および縮 合物もしくはいずれか一方と(B)下記一般式(3)で 表される化合物

HO- (SiR8R9O) .H .... (3)

(R®およびR®は、同一でも異なっていてもよく、それ ぞれ1価の有機基を示し、eは2~100の整数を示 す。)を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 β-ジケトン、250~450℃に沸点 または分解退度を有する化合物、界面活性剤の群から選 20 ばれる少なくとも 1種をさらに含有することを特徴とす る請求項1記載の膜形成用組成物。

[請求項3] 前記(A)成分と(B)成分が下記一般 式(4)で表される金属のキレート化合物、

. . . . . (4) R<sup>10</sup> fM (OR<sup>11</sup>) g-f

(R<sup>10</sup> はキレート剤、Mは金属原子、R<sup>11</sup> は炭素数2~ 5のアルキル基または炭素数6~20のアリール基を示 し、gは金属Mの原子価、fは0~gの整数を表す。) 酸性触媒および塩基性触媒の群から選ばれる少なくとも 1種の存在下に加水分解されることを特徴とする請求項 30 1 記載の膜形成用組成物。

(A) 成分に対する(B) 成分の使用割 【請求項4】 合が、(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物換 算)で(B)成分0.2~20重量部であることを特徴 とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項5】 請求項1~4記載の膜形成用組成物から なることを特徴とする絶縁膜形成用材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 **線膜材料として、適当な均一な厚さを有する塗膜が形成** 可能な、塗膜の機械的強度やクラック耐性やCMP(C hemical Mechanical Polishi ng) 耐性に優れ、かつ低比誘電率の塗膜が得られる膜 形成用組成物に関する。

[0003]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 **糢として、CVD法などの真空プロセスで以て形成され 50** 

(R<sup>1</sup>は水崇原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、R<sup>2</sup>は1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表 す。) および (A-2) 下記一般式 (2) で表される化

たシリカ (SiOz) 膜が多用されている。そして、近 年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的とし て、SOG (Spin on Glass) 膜と呼ばれ るテトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とす る塗布型の絶縁膜も使用されるようになっている。ま た、半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼 ばれるポリオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電 率の層間絶縁膜が開発されている。しかしながら、半導 体素子などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優 れた導体間の電気絶縁性が要求されており、したがっ て、より低比誘電率で表面硬度特性に優れる層間絶縁膜 材料が求められるようになっている。

【0004】そこで、特開平6-181201号公報に は、層間絶線膜材料として、より低比誘電率の絶線膜形 成用塗布型組成物が開示されている。この塗布型組成物 は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の 絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、 チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ば れる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分 子内にアルコキシ基を少なくとも 1 個有する有機ケイ素 化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以 上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成 物である。

【0005】また、WO96/00758号公報には、 多層配線基板の層間絶縁膜の形成に使用される、アルコ キシシラン類、シラン以外の金属アルコキシドおよび有 機溶媒などからなる、厚膜塗布が可能で、かつ耐酸素ブ ラズマ性に優れるシリカ系塗布型絶縁膜形成用材料が開 示されている。

【0006】さらに、特開平3-20377号公報に は、電子部品などの表面平坦化、層間絶縁などに有用な 酸化物被膜形成用塗布液が開示されている。この酸化物 被膜形成用塗布液は、ゲル状物の発生のない均一な塗布 液を提供し、また、この塗布液を用いることにより、高 温での硬化、酸素プラズマによる処理を行った場合であ っても、クラックのない良好な酸化物被膜を得ることを 目的としている。そして、その構成は、所定のシラン化 合物と、同じく所定のキレート化合物とを有機溶媒の存 在化で加水分解し、重合して得られる酸化物被膜形成用 塗布液である。

【0007】しかし、上記のようにシラン化合物にチタ ンやジルコニウムなどの金属キレート化合物を組み合せ た場合、塗膜の機械的強度やクラック耐性やCMP耐性 や低比誘電率などをバランスよく有するものではない。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点を解決するための腹形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、低比新電学特性、クラック耐性、基板との密着性等のバランスにも優れた層間絶縁膜用材料を提供することを目的とする。

$$R^{3}_{b}$$
 (R<sup>4</sup>O) 3-6 S i - (R<sup>7</sup>) 4-S i (OR<sup>5</sup>) 3-c R<sup>6</sup>c . . . . . (2)

 $(R^3, R^4, R^5$ および $R^6$ は、同一でも異なっていても 10 ロポキシシラン、テトラーisoープロポキシシラン、よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同一でも異なっていてもよく、 $0\sim 2$ の数を示し、 $R^7$ は シラン、テトラーtertーブトキシシラン、テトラフ酸素原子または一( $CH_2$ )aーで表される基を示し、n は1 $\sim$ 6を、dは0または1を示す。)からなる群より 選ばれる少なくとも1種の化合物の加水分解物および縮ラン、メチルトリーisoープロポキシシラン、メチルトリーをertーブトキシシラン、メチルトリーをertーブトキシシラン、メチルトリーをertーブトキシシラン、メチルトリーをertーブトキシシラン、

 $HO-(SiR^8R^9O) \cdot H \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$ 

(R<sup>8</sup>およびR<sup>9</sup>は、同一でも異なっていてもよく、それ ぞれ1価の有機基を示し、eは2~100の整数を示 す。)を含有することを特徴とする膜形成用組成物およ び絶縁膜形成用材料を提供するものである。

[0010]

【発明の実施の形態】<u>(A)成分</u>

#### <u>(A-1)成分</u>

上記一般式(1)において、R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>の1価の有機 基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリ シジル基などを挙げることができる。また、一般式

(1)において、R<sup>1</sup>は1価の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であることが好ましい。ここで、アル 30 キル基としては、メチル基、エチル基、ブロビル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式(1)において、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。

【0011】一般式(1)で表される化合物の具体例としては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリーロポキシシラン、トリーisoープロポキシシラン、トリーローブトキシシラン、トリーsecーブトキシシラン、トリーtertーブトキシシラン、フルオロトリートーブロポキシシラン、フルオロトリーisoープロポキシシラン、フルオロトリーsecーブトキシシラン、フルオロトリーsecーブトキシシラン、アトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーローブ 50

【0009】本発明は、(A) (A-1)下記一般式 (1) で表される化合物 R<sup>1</sup> a S i (OR<sup>2</sup>) ←a ·····(1)

 $(R^1$  t 水素原子、フッ素原子または 1 価の有機基を示し、 $R^2$  は 1 価の有機基を示し、a は  $0\sim 2$  の整数を表す。) および (A-2) 下記一般式 (2) で表される化合物

テトラーnープトキシラン、テトラーsecープトキシ シラン、テトラーtertープトキシシラン、テトラフ ェノキシシランなど:メチルトリメトキシシラン、メチ ルトリエトキシシラン、メチルトリーロープロポキシシ ラン、メチルトリーiso-プロポキシシラン、メチル トリーロープトキシシラン、メチルトリーsecープト キシシラン、メチルトリーtertープトキシシラン、 メチルトリフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラ ン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリーロープロ ポキシシラン、エチルトリーiso-プロポキシシラ ン、エチルトリーnープトキシシテン、エチルトリーs ecープトキシシラン、エチルトリーtertープトキ シシラン、エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメ トキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリ ーnープロポキシシラン、ビニルトリーisoープロポ キシシラン、ビニルトリーnーブトキシシラン、ビニル トリーsecーブトキシシラン、ピニルトリーtert ープトキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、ロープロピルトリエトキ シシラン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、 .nープロピルトリーisoープロポキシシラン、nープ. ロピルトリーロープトキシシラン、ロープロピルトリー・ secーブトキシシラン、ロープロピルトリーtert ープトキシシラン、nープロピルトリフェノキシシラ ン、iープロピルトリメトキシシラン、iープロピルト リエトキシシラン、iープロピルトリーロープロポキシ シラン、iープロピルトリーisoープロポキシシラ ン、iープロピルトリーnープトキシシラン、iープロ ピルトリーsec-ブトキシシラン、i-プロピルトリ -tert-ブトキシシラン、i-プロピルトリフェノ キシシラン、n-プチルトリメトキシシラン、n-ブチ ルトリエトキシシラン、nープチルトリーnープロポキ シシラン、nープチルトリーisoープロポキシシラ ン、nープチルトリーnープトキシシラン、nープチル トリーsecープトキシシラン、nープチルトリーte rtープトキシシラン、nープチルトリフェノキシシラ ン、secーブチルトリメトキシシラン、secーブチ ルーi-トリエトキシシラン、sec-ブチルートリー nープロポキシシラン、secーブチルートリーiso ープロポキシシラン、secーブチルートリーnーブト

キシシラン、secーブチルートリーsecーブトキシ

シラン、secーブチルートリーtertーブトキシシラン、secーブチルートリフェノキシシラン、tーブ

**チルトリメトキシシラン、t-ブチルトリエトキシシラ** 

ン、モーブチルトリーロープロポキシシラン、モーブチ ルトリーisoープロポキシシラン、モーブチルトリー nーブトキシシラン、tープチルトリーsecープトキ シシラン、tープチルトリーtertープトキシシラ ン、tープチルトリフェノキシシラン、フェニルトリメ トキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニル 10 トリーnープロポキシシラン、フェニルトリーisoー プロポキシシラン、フェニルトリーロープトキシシラ ン、フェニルトリーsecーブトキシシラン、フェニル トリーtertープトキシシラン、フェニルトリフェノ キシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエ トキシシラン、ソーアミノブロピルトリメトキシシラ ン、ャーアミノプロピルトリエトキシシラン、ャーグリ シドキシプロピルトリメトキシシラン、ァーグリシドキ シプロピルトリエトキシシラン、γートリフロロプロピ ルトリメトキシシラン、ャートリフロロプロピルトリエ 20 トキシシランなどくジメチルジメトキシシラン、ジメチ ルジエトキシシラン、ジメチルージーn-プロポキシシ ラン、ジメチルージーisoープロポキシシラン、ジメ チルージーnープトキシシラン、ジメチルージーsec ープトキシシラン、ジメチルージーtert゚ープトキシ シラン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメト キシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージ ーnープロポキシシラン、ジエチルージーisoープロ ポキシシラン、ジエチルージーロープトキシシラン、ジ エチルージーsecーブトキシシラン、ジエチルージー 30 tertープトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラ ン、ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロ ピルジエトキシシラン、ジーロープロピルージーロープ ロポキシシラン、ジーnープロピルージーisoープロ ポキシシラン、ジーnープロピルージーnープトキシシ ラン、ジーnープロピルージーsecープトキシシラ ン、ジーnープロピルージーtertープトキシシラ ン、ジーnープロピルージーフェノキシシラン、ジーi soープロピルジメトキシシラン、ジーisoープロピ ルジエトキシシラン、ジーiso-プロピルージーn- 40 プロポキシシラン、ジーisoープロピルージーiso ープロポキシシラン、ジーisoープロピルージーnー

プトキシシラン、ジーisoープロピルージーsecー

ブトキシシラン、ジーisoープロピルージーtest

ープトキシシラン、ジーisoープロピルージーフェノ

キシシラン、ジーnープチルジメトキシシラン、ジーn

ープチルジエトキシシラン、ジーロープチルージーロー

プロポキシシラン、ジーローブチルージーisoープロ

ポキシシラン、ジーn-ブチル-ジ-n-ブトキシシラン、ジ-n-ブチル-ジ-sec-ブドキシシラン、ジ 50

ーnープチルージーtertーブトキシシラン、ジーn ープチルージーフェノキシシラン、ジーsecープチル ジメトキシシラン、ジーsec-プチルジエトキシシラ ン、ジーsecーブチルージーnープロポキシシラン、 ジーsecーブチルージーisoープロポキシシラン、 ジーsecーブチルージーnーブトキシシラン、ジーs ecープチルージーsecープトキシシラン、ジーse cーブチルージーtertーブトキシシラン、ジーse cープチルージーフェノキシシラン、ジーtertーブ チルジメトキシシラン、ジーtertープチルジエトキ シシラン、ジーtertーブチルージーnープロポキシ シラン、ジーtertーブチルージーisoープロポキ シシラン、ジーtertーブチルージーnープトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーsecープトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーtertープトキシ シラン、ジーtert-ブチルージーフェノキシシラ ン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエ トキシシラン、ジフェニルージーロープロポキシシラ ン、ジフェニルージーisoープロポキシシラン、ジフ ェニルージー n ープトキシシラン、ジフェニルージー s ecープトキシシラン、ジフェニルージーtertープ トキシシラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジピニ ルトリメトキシシラン、γーアミノプロピルトリメトキ シシラン、γーアミノプロピルトリエトキシシラン、γ ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ャーグリ シドキシプロピルトリエトキシシラン、ャートリフロロ プロピルトリメトキシシラン、ソートリフロロプロピル トリエトキシシランなど;を挙げることができる。これ らのうち好ましいものとしては、テトラメトキシシラ ン、テトラエトキシシラン、テトラーnープロポキシシ ラン、テトラーisoープロポキシシラン、テトラフェ ノキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリ エトキシシラン、メチルトリーロープロポキシシラン、 メチルトリーisoープロポキシシラン、エチルトリメ トキシシラン、エチルトリエトキシシラン、ビニルトリ メトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、フェニル トリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジ メチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、 ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラ ン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキ シシラン、トリメチルモノメトキシシラン、トリメチル モノエトキシシラン、トリエチルモノメトキシシラン、 トリエチルモノエトキシシラン、トリフェニルモノメト キシシラン、トリフェニルモノエトキシシランが挙げら れ、特に好ましい例として、テトラメトキシシラン、テ トラエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチ ルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジ メチルジエトキシシランを挙げることができる。 これら は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。 【0012】 (A-2) 成分

上記一般式 (2) において、1価の有機基としては、先 の一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。 【0013】また、一般式 (2) のR'である2価の有 機基としては、メチレン基、炭素数2~6のアルキレン 基などを挙げることができる。一般式(2)のうち、R 「が酸素原子の化合物としては、ヘキサメトキシジシロ キサン、ヘキサエトキシジシロキサン、ヘキサフェノキ シジシロキサン、1、1、1、3、3ーペンタメトキシ -3-メチルジシロキサン、1,1,1,3,3-ペン タエトキシー3ーメチルジシロキサン、1,1,1, 3, 3-ペンタメトキシー3-フェニルジシロキサン、 1、1、1、3、3ーペンタエトキシー3ーフェニルジ シロキサン、1, 1, 3, 3ーテトラメトキシー1, 3 ージメチルジシロキサン、1,1,3,3ーテトラエト キシー1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3 ーテトラメトキシー1、3ージフェニルジシロキサン、 1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジフェニル ジシロキサン、1, 1, 3-トリメトキシー1, 3, 3 ートリメチルジシロキサン、1, 1, 3ートリエトキシ -1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1, 1, 3- 20 トリメトキシー1,13,3ートリフェニルジシロキサ ン、1、1、3-トリエトキシー1、3、3-トリフェ ニルジシロキサン、1,3ージメトキシー1,1,3, 3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジエトキシー 1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシー1, 1, 3, 3ーテトラフェニルジシロキ サン、1,3-ジェトキシー1,1,3,3-テトラフ ェニルジシロキサンなどを挙げることができる。

【0014】これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサン、1, 1, 3, 3-テ 30トラメトキシー1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシー1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジエトキシー1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシー1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3-ジェトキシー1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3-ジェトキシー1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げることができる。

メトキシー1, 2ージフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジフェニルジシラン、 1、1、2-トリメトキシー1、2、2-トリメチルジ シラン、1, 1, 2ートリエトキシー1, 2, 2ートリ メチルジシラン、1、1、2ートリメトキシー1、2、 2ートリフェニルジシラン、1, 1, 2ートリエトキシ -1, 2, 2-トリフェニルジシラン、1, 2-ジメト キシー1、1、2、2ーテトラメチルジシラン、1、2 ージエトキシー1, 1, 2, 2ーテトラメチルジシラ ン、1、2-ジメトキシー1、1、2、2-テトラフェ ニルジシラン、1, 2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシランなどを、一般式(2)において R<sup>7</sup>が一(CH<sub>2</sub>)。一で表される基の化合物としては、 ピス (ヘキサメトキシシリル) メタン、ピス (ヘキサエ トキシシリル)メタン、ピス(ヘキサフェノキシシリ ル) メタン、ピス (ジメトキシメチルシリル) メタン、 ピス (ジエトキシメチルシリル) メタン、ピス (ジメト キシフェニルシリル) メタン、ピス(ジエトキシフェニ ルシリル) メタン、ビス (メトキシジメチルシリル) メ タン、ピス (エトキシジメチルシリル) メタン、ピス (メトキシジフェニルシリル) メタン、ビス (エトキシ ジフェニルシリル) メタン、ピス (ヘキサメトキシシリ ル) エタン、ピス (ヘキサエトキシシリル) エタン、ビ ス (ヘキサフェノキシシリル) エタン、ビス (ジメトキ シメチルシリル) エタン、ピス (ジエトキシメチルシリ ル) エタン、ビス (ジメトキシフェニルシリル) エタ ン、ピス (ジエトキシフェニルシリル) エタン、ピス (メトキシジメチルシリル) エタン、ピス (エトキシジ メチルシリル) エタン、ビス (メトキシジフェニルシリ ル) エタン、ピス (エトキシジフェニルシリル) エタ ン、1, 3-ビス (ヘキサメトキシシリル) プロパン、 1, 3-ビス (ヘキサエトキシシリル) プロパン、1, 3-ビス (ヘキサフェノキシシリル) プロパン、1,3 ービス (ジメトキシメチルシリル) プロパン、1,3-ビス (ジエトキシメチルシリル) プロパン、1,3-ビ ス (ジメトキシフェニルシリル) プロパン、1, 3-ビ ス (ジエトキシフェニルシリル) プロパン、1, 3-ビ ス (メトキシジメチルシリル) プロパン、1, 3ービス (エトキシジメチルシリル) プロパン、1, 3ービス (メトキシジフェニルシリル) プロパン、1, 3-ビス (エトキシジフェニルシリル) プロパンなどを挙げるこ とができる。これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、 ヘキサエトキシジシラン、ヘキサフェニキシジシラン、 1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジメチルジ シラン、1, 1, 2, 2ーテトラエトキシー1, 2ージ メチルジシラン、1, 1, 2, 2ーテトラメトキシー 1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラ エトキシー1、2ージフェニルジシラン、1、2ージメ 「トキシー1, 1, 2, 2ーテトラメチルジシラン、1,

ン、1, 2-ジメトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、ビス(ヘキサメトキシシリル)メタン、ビス(ヘキサエトキシシリル)メタン、ビス(ジエトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジエトキシフェニルシリル)メタン、ビス(ジエトキシフェニルシリル)メタン、ビス(メトキンジメチルシリル)メタン、ビス(メトキシジメチルシリル)メタン、ビス(メトキシジメチルシリル)メタン、ビス(メトキシジフェニルシリル)メタン、ビス(エトキシジフェニルシリル)メタンを、好ましい例として挙げることができる。本発明において、(A)成分としては、上記(A-1)成分および(A-2)成分はそれぞれ2種以上用いることもできる。

【0016】\_(B) 成分

上記一般式(3)において、1価の有機基としては、先の一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。一般式(3)で表される化合物の具体例としては、末端とドロキシポリジメチルシロキサン、末端とドロキシポリジエチルシロキサン、末端とドロキシポリジフェニルシロキサン、末端とドロキシポリジフェニルシロキサン共重合体などを挙げることができ、末端とドロキシポリジメチルシロキサン大末端とドロキシポリジメチルシロキサン、末端とドロキシポリジフェニルシロキサン、末端とドロキシポリジフェニルシロキサン、末端とドロキシポリジフェニルシロキサン、末端とドロキシポリジフェニルシロキサン、末端とドロキシポリジフェニルシロキサン、末端とドロキシポリジメチルシロキサンーポリジフェニルシロキサン共重合体が好ましい

(3) 中のeが2~100、好ましくは2~50である。これら(C)成分は1種または2種以上を同じに使用しても良い。本発明において、(A)成分に対する(B)成分の使用割合は、(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物換算)で(B)成分0.2~20重量部である。(B)成分の使用割合が20重量部を超えると塗膜の耐熱性が劣化する。本発明において、加水分解とは、上記(A)成分に含まれるR²O一基、R¹O一基、およびR³O一基すべてが加水分解されている必要はなく、例えば1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水分解されているもの、あるいは、これらの40

【0017】ポリマーの繰り返し数としては、一般式

【0018】本発明において縮合とは(A)成分の加水分解物のシラノール基および(B)成分のシラノール基 が縮合してSi-O-Si結合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの混合物などをも生成することを包含した概念である。なお、加水分解縮合物の重量平均分子量は、通常、1,000~120,000、分ましくは1,200~100,000程度であ

混合物が生成することである。

る。本発明において(A)成分を加水分解する際には、 ・触媒を使用することが好ましく、その触媒としては、一 般式(4)で示される金属キレート化合物、酸性触媒、 塩基性触媒を挙げることができる。

10

【0019】金属キレート化合物としては、例えば、ト リエトキシ・モノ(アセチルアセトナート)チタン、ト リーロープロポキシ・モノ(アセチルアセトナート)チ タン、トリーiープロポキシ・モノ(アセチルアセトナ ート) チタン、トリーロープトキシ・モノ (アセチルア 10 セトナート) チタン、トリーsecープトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーェーブトキシ ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーロープロポ キシ・ビス(アセチルアセトナート)チタン、ジーi-プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジ ーnープトキシ・ビス(アセチルアセトナート)チタ ン、ジーsecーブトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) チタン、ジーτーブトキシ・ビス(アセチルアセト ナート) チタン、モノエトキシ・トリス (アセチルアセ トナート) チタン、モノーロープロポキシ・トリス (ア セチルアセトナート)チタン、モノーiープロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーロープ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノ -sec-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーェーブトキシ・トリス(アセチルアセト ナート) チタン、テトラキス (アセチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モノ(エチルアセトアセテー ト) チタン、トリーロープロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) チタン、トリーiープロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーnープトキ シ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーs e cープトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタ ン、トリーtーブトキシ・モノ(エチルアセトアセテー ト) チタン、ジエトキシ・ビス (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジーnープロポキシ・ビス (エチルアセト アセテート) チタン、ジー i ープロポキシ・ビス (エチ ルアセトアセテート) チタン、ジーnープトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーsecーブト キシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジー t ープトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、 モノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノーロープロポキシ・トリス(エチルアセトアセ テート) チタン、モノーiープロポキシ・トリス (エチ ルアセトアセテート) チタン、モノーαーブトキシ・ト リス(エチルアセトアセテート)チタン、モノーsec ープトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) テタ ン、モノーェーブトキシ・トリス(エチルアセトアセテ ート) チタン、テトラキス (エチルアセトアセテート) 'チタン、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチル アセトアセテート) チタン、ピス (アセチルアセトナー

ト) ピス (エチルアセトアセテート) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト) チタンなどのチタンキレート化合物; トリエトキシ ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリー n-プロポキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、トリーiープロポキシ・モノ(アセチルアセト ナート) ジルコニウム、トリーローブトキシ・モノ (ア セチルアセトナート) ジルコニウム、トリーsecーブ トキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、 トリーェーブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジ 10 ルコニウム、ジエトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジーロープロポキシ・ピス (アセチ ルアセトナート) ジルコニウム、ジーiープロポキシ・ ピス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーロー ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、ジーsecーブトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジーェーブトキシ・ピス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノーロープ ロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウ 20 ム、モノーiープロポキシ・トリス(アセチルアセトナ ート) ジルコニウム、モノーロープトキシ・トリス (ア セチルアセトナート) ジルコニウム、モノーsecーブ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノーtーブトキシ・トリス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、テトラキス (アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、トリエトキシ・モノ(エチルアセト アセテート) ジルコニウム、トリーロープロポキシ・モ ノ(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、トリーi... ープロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコ 30 ニウム、トリーnープトキシ・モノ(エチルアセトアセ テート) ジルコニウム、トリーsecーブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリーtー ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウ ム、ジエトキシ・ピス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、ジーnープロポキシ・ピス (エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジーiープロポキシ・ピス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーローブ トキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウ ム、ジーsecーブトキン・ピス(エチルアセトアセテ 40 ート) ジルコニウム、ジーt-ブトキシ・ピス(エチル アセトアセテート) ジルコニウム、モノエトキシ・トリ ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノーロ ープロポキシ・トリス(エチルアセトアセテート)ジル コニウム、モノーiープロポキシ・トリス(エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、モノーnーブトキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー secーブトキシ・トリス(エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノーtーブトキシ・トリス(エチルア

セトアセテート) ジルコニウム、テトラキス(エチルア 50

12

セトアセテート) ジルコニウム、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ビス (アセチルアセトナート) ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウムなどのジルコニウムキレート化合物; トリス (アセチルアセトナート) アルミニウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウムなどのアルミニウムキレート化合物: などを挙げることができる。

【0020】酸性触媒としては、有機酸および無機酸を学げることができる。有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘブタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、2-エチルヘキサン酸、サリチル酸、安息香酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、p-アミノ安息香酸、p-トルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、ドリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸などを挙げることができる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸などを挙げることができる。

【0021】塩基性触媒としては、有機塩基および無機 塩基を挙げることができる。有機塩基としては、例え ば、ピリジン、ピロール、ピペラジン、ピロリジン、ピ ペリジン、ピコリン、モノメチルアミン、ジメチルアミ ン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルア ミン、トリエチルアミン、モノプロピルアミン、ジプロ ピルアミン、トリプロピルアミン、モノブチルアミン、 ジブチルアミン、トリブチルアミン、モノエタノールア ミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノールア ミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタノール アミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシクロノナ ン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルアンモニ ウムハイドロオキサイドなどを挙げることができる。無 機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、水酸化カルシウ ムなどを挙げることができる。

【0022】これら触媒のうち、金属キレート化合物、有機酸、無機酸、有機塩基が好ましく、より好ましくは、チタンキレート化合物、アルミキレート化合物、有機酸、有機塩基を挙げることができる。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。上記触媒の使用量は、(A)成分(完全加水分解縮合物換算)100重量部に対して、通常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~10重量部の範囲である。また、触媒は、前記容剤中に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分散させておいてもよい。本発

明の膜形成用組成物は、(A)成分を触媒と水の存在下 で反応させた加水分解物および縮合物もしくはいずれか 一方と (B) 成分を有機溶剤に溶解または分散してな る。本発明に使用する有機溶剤としては、例えば、nー ペンタン、iーペンタン、nーヘキサン、iーヘキサ ン、n-ヘプタン、i-ヘプタン、2, 2, 4-トリメ チルペンタン、nーオクタン、iーオクタン、シクロへ キサン、メチルシクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素系 溶性・ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼ ン、トリメチルベンゼン、メチルエチルベンゼン、n-プロピルベンセン、i-プロピルベンセン、ジエチルベ ンゼン、iープチルベンゼン、トリエチルベンゼン、ジ ーiープロピルペンセン、nーアミルナフタレン、トリ メチルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶媒;メタノー ル、エタノール、nープロパノール、iープロパノー ル、nープタノール、iープタノール;secープタノ ール、tーブタノール、nーペンタノール、iーペンタ ノール、2ーメチルブタノール、secーペンタノー ル、 tーペンタノール、3ーメトキシブタノール、nー ヘキサノール、2ーメチルペンタノール、5 e c ーヘキ サノール、2ーエチルブタノール、secーヘプタノー ル、ヘプタノールー3、nーオクタノール、2ーエチル ヘキサノール、secーオクタノール、nーノニルアル コール、2,6-ジメチルヘプタノールー4、nーデカ ノール、 s e c ーウンデシルアルコール、トリメチルノ ニルアルコール、secーテトラデシルアルコール、s e cーヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘ キサノール、メチルシクロヘキサノール、3,3,5-トリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、 フェニルメチルカルビノール、ジアセトンアルコール、 クレソールなどのモノアルコール系容媒;エチレングリ コール、1, 2ープロピレングリコール、1, 3ープチ レングリコール、ペンタンジオールー2、4、2ーメチ ルペンタンジオールー2,4、ヘキサンジオールー2, 5、ヘプタンジオールー2、4、2-エチルヘキサンジ オールー1, 3、ジエチレングリコール、ジプロピレン グリコール、トリエチレングリコール、トリプロピレン グリコール、グリセリンなどの多価アルコール系溶媒; アセトン、メチルエチルケトン、メチルーnープロピル ケトン、メチルーnーブチルケトン、ジエチルケトン、 メチルーiーブチルケトン、メチルーnーペンチルケト .ン、エチルーローブチルケトン、メチルーローヘキシル ケトン、ジーiーブチルケトン、トリメチルノナノン、 シクロヘキサノン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキ サノン、2, 4ーペンタンジオン、アセトニルアセト ン、ジアセトンアルコール、アセトフェノン、フェンチ ョンなどのケトン系溶媒;エチルエーテル、iープロピ ルエーテル、nープチルエーテル、nーヘキシルエーテ ル、2-エチルヘキシルエーテル、エチレンオキシド、

ルジオキソラン、ジオキサン、ジメチルジオキサン、エ チレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコ ールモノエチルエーテル、エチレングリコールジエチル エーテル、エチレングリコールモノーロープチルエーテ ル、エチレングリコールモノーローヘキシルエーテル、 エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレング リコールモノー2ーエチルブチルエーテル、エチレング リコールジプチルエーテル、ジエチレングリコールモノ メチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエー テル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチ レングリコールモノーローブチルエーテル、ジエチレン グリコールジーnープチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノーローヘキシルエーテル、エトキシトリグリコ ール、テトラエチレングリコールジーnーブチルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ ールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノ ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジブロピレングリコールモノエチルエーテル、 トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、テトラ ヒドロフラン、2ーメチルテトラヒドロフランなどのエ ーテル系溶媒;ジエチルカーボネート、酢酸メチル、酢 酸エチル、γーブチロラクトン、γーバレロラクトン、 酢酸n-プロピル、酢酸i-プロピル、酢酸n-ブチ ル、酢酸iーブチル、酢酸secーブチル、酢酸nーペー ンチル、酢酸secーペンチル、酢酸3ーメトキシブチ ル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エチルブチル、酢酸 2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘキシ ル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸nーノニル、アセ ト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸エチレングリコ ールモノメチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノ エチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノメチル エーテル、酢酸ジェチレングリコールモノエチルエーテ ル、酢酸ジエチレングリコールモノーロープチルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢 酸プロピレングリコールモノエチルエーテル、酢酸プロ ピレングリコールモノプロピルエーテル、酢酸プロピレ ングリコールモノブチルエーテル、酢酸ジプロピレング リコールモノメチルエーテル、酢酸ジプロピレングリコ ールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリコール、酢酸メト キシトリグリコール、プロピオン酸エチル、プロピオン 酸n-ブチル、プロピオン酸i-アミル、シュウ酸ジエ チル、シュウ酸ジーn-ブチル、乳酸メチル、乳酸エチ ル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミル、マロン酸ジエチ ル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチルなどのエステ ル系溶媒;Nーメチルホルムアミド、N,Nージメチル ホルムアミド、N, Nージエチルホルムアミド、アセト アミド、Nーメチルアセトアミド、N,Nージメチルア ·セトアミド、Nーメチルプロピオンアミド、Nーメチル 1, 2-プロピレンオキシド、ジオキソラン、4-メチ 50 ピロリドンなどの含窒素系溶媒;硫化ジメチル、硫化ジ

16

エチル、チオフェン、テトラヒドロチオフェン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、1,3-プロパンスルトンなどの含硫黄系容媒などを挙げることができる。

【0023】これらの中で、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテルを挙げることができ、特に好ましくはプロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノアロピルエーテルが特に好ましい。これら有機容剤は、1種あるいは2種以上を混合して使用することができる。

【0024】本発明の膜形成用組成物は、下記のとおり製造することができる。具体的には、(A)成分を溶解させた有機溶剤中に水を断続的あるいは連続的に添加する。この際、触媒は、有機溶剤中に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分散させておいてもよい。この際の反応温度としては、通常、0~100℃、好ましくは15~80℃である。また、膜形成用組成物を構成するにあたり、組成物中の沸点100℃以下のアルコールの含量が、20重量%以下、特に5重量%以下であることが好ましい。沸点100℃以下のアルコールは、上記(A-1)成分ならびに(A-2)成分の加水分解および/またはその縮合の際に生じる場合があり、その含量が20重量%以下になるように蒸留などにより除去することが好ましい。

【0025】本発明で得られる膜形成用組成物には、さ らにβ-ジケトン、250~450℃に有機ポリマー、 界面活性剤、コロイド状シリカ、コロイド状アルミナ、 などの成分を添加してもよい。 βージケトンとしては、 アセチルアセトン、2,4-ヘキサンジオン、2,4-ヘプタンジオン、3, 5ーヘプタンジオン、2, 4ーオ クタンジオン、3,5-オクタンジオン、2,4-ノナ ンジオン、3,5-ノナンジオン、5-メチルー2,4 ーヘキサンジオン、2,2,6,6ーテトラメチルー 3, 5ーヘプタンジオン、1, 1, 1, 5, 5, 5ーへ キサフルオロー2, 4-ヘプタンジオンなどの1種また は2種以上である。本発明において、膜形成用組成物中 40 の B - ジケトン含有量は、(A)成分(完全加水分解箱 合物換算)の合計量100重量部に対して通常0.1~ 100重量部、好ましくは0.2~80重量部の範囲で ある。このような範囲でβ-ジケトンを添加すれば、-定の保存安定性が得られるとともに、膜形成用組成物の 塗膜均一性などの特性が低下するおそれが少ない。この β ージケトンは、(A)成分の加水分解、縮合反応後に 添加することが好ましい。

【0026】250~450℃に沸点または分解温度を 有する化合物としては有機ポリマーを挙げることができ 50 る。有機ポリマーとしては、例えば、ポリアルキレンオキサイド構造を有する化合物、糖鎖構造を有する化合物、ビニルアミド系重合体、(メタ)アクリレート重合体、芳香族ビニル化合物、デンドリマー、ポリイミド、ポリアミック酸、ポリアリーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、ポリオキサジアゾール、フッ素系重合体などを挙げることができる。ポリアルキレンオキサイド構造、ポリメチレンオキサイド構造、ポリアトラメチレンオキサイド構造、ポリアトラメチレンオキサイド構造、ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブテレンオキシド構造などが挙げられる。

【0027】具体的には、ポリオキシメチレンアルキル エーテル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリ オキシエテチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキ シエチレンステロールエーテル、ポリオキシエチレンラ ノリン誘導体、アルキルフェノールホルマリン縮合物の 酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレンポリオキシブ ロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリ オキシプロピレンアルキルエーテルなどのエーテル型化 合物、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、 ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオ キシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシ エチレン脂肪酸アルカノールアミド硫酸塩などのエーテ ルエステル型化合物、ポリエチレングリコール脂肪酸エ ステル、エチレングリコール脂肪酸エステル、脂肪酸モ ノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビ タン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エス テル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエーテルエステル型 化合物などを挙げることができる。ポリオキシチレンポ リオキシプロピレンブロックコポリマーとしては下記の ようなプロック構造を有する化合物が挙げられる。

[0028] - (A) o - (B) p - (A) o - (B) p - (A) q -

(式中、AはーCH2 CH2 Oーで表される基を、BはーCH2 CH (CH3) Oーで表される基を示し、oは1~90、pは10~99、qは0~90の数を示す)
これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシブロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシブロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、などのエーテル型化合物をより好ましい例として挙げることができる。

【0029】これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。(メタ)アクリル系重合体としては、ポリオキシエチル基、ポリオキシブロビル基、アミド基、ヒドロキシル基、カルボキシル基の群より選ばれた少なくとも1種を有する(メタ)アクリル系重合体が挙げられる。上記(メタ)アクリル系重合体は、アクリル酸、

メタクリル酸、上記官能基を有するアクリル酸誘導体、 上記官能基を有するメタクリル酸誘導体、上記官能基を 有さないアクリル酸エステルおよび上記宮能基を有さな いメタクリル酸エステルより構成される。上記官能基を 有するアクリル酸誘導体の具体例としては、2-ヒドロ キシエチルアクリレート、ジエチレングリコールアクリ レート、ポリエチレングリコールアクリレート、メトキ シジエチレングリコールアクリレート、メトキシポリエ チレングリコールアクリレート、エトキシジエチレング リコールアクリレート、エトキシポリエチレングリコー 10 ルアクリレート、2-ヒドロキシブロピルアクリレー ト、ジプロピレングリコールアクリレート、ポリプロピ レングリコールアクリレート、メトキシジプロピレング リコールアクリレート、メトキシポリプロピレングリコ ールアクリレート、エトキシジプロピレングリコールア クリレート、エトキシポリプロピレングリコールアクリ レート、2ージメチルアミノエチルアクリレート、2ー ジエチルアミノエチルアクリレート、N-ピニルピロリ ドン、ビニルビリジン、アクリルアミド、Nーメチルア クリルアミド、N, Nージメチルアクリルアミド、Nー 20 メチロールアクリルアミド、グリシジルアクリレートな どのモノアクリレート類:ジエチレングリコールジアク リレート、ポリエチレングリコールジアクリレートなど のジアクリレート類;などが挙げられる。これらは、1

種または2種以上を同時に使用してもよい。 【0030】上記官能基を有するメタクリル酸誘導体の 具体例としては、2ーヒドロキシエチルメタクリレー ト、ジエチレングリコールメタクリレート、ポリエチレ ングリコールメタクリレート、メトキシジエチレングリ コールメタクリレート、メトキシポリエチレングリコー 30 ルメタクリレート、エトキシジエチレングリコールメタ クリレート、エトキシポリエチレングリコールメタクリ レート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート、ジブ ロピレングリコールメタクリレート、ポリプロピレング リコールメタクリレート、メトキシジプロピレングリコ ールメタクリレート、メトキシポリプロピレングリコー ルメタクリレート、エトキシジプロピレングリコールメ タクリレート、エトキシポリプロピレングリコールメタ クリレート、2-ジメチルアミノエチルメタクリレー ト、2-ジエチルアミノエチルメタクリレート、メタク リルアミド、Nーメチルメタクリルアミド、N, Nージ メチルメタクリルアミド、Nーメチロールメタクリルア ミド、グリシジルメタクリレートなどのモノメタクリレ ート類;ジエチレングリコールジメタクリレート、ポリ エチレングリコールジメタクリレート、ジプロピレング リコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコール ジメタクリレートなどのジメタクリレート類:などが挙 げられる。これらは、1種または2種以上を同時に使用 してもよい。

【0031】上記官能基を有さないアクリル酸エステル

の具体例としては、メチルアクリレート、エチルアクリ レート、ロープロピルアクリレート、isoープロピル アクリレート、ロープチルアクリレート、isoープチ ルアクリレート、secーブテルアクリレート、ter ープチルアクリレート、アミルアクリレート、ヘキシル アクリレート、ヘプチルアクリレート、オクチルアクリ レート、ノニルアクリレート、デシルアクリレート、ド デシルアクリレート、テトラデシルアクリレート、ヘキ サデシルアクリレート、オクタデシルアクリレート、シ クロヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリ レート、2-メトキシエチルアクリレート、2-エトキ シエチルアクリレート、2ーメトキシプロピルアクリレ ート、2-エトキシプロピルアクリレート、ベンジルア クリレート、フェニルカルビトールアクリレート、ノニ ルフェニルアクリレート、ノニルフェニルカルピトール アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリ レート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、イソボ ルニルアクリレートなどのモノアクリレート類;エチレ ングリコールジアクリレート、1,3ープチレングリコ ールジアクリレート、1, 4ープチレングリコールジア クリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、 1,6-ヘキサングリコールジアクリレート、2,2-ビス (4-アクリロキシプロピロキシフェニル) プロバ ン、2、2-ビス(4-アクリロキシジエトキシフェニ ル) プロパンなどのジアクリレート類:トリメチロール エタントリアクリレート、トリメチロールプロパントリ アクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート などのトリアクリレート類 ; ペンタエリスリトールテト ラアクリレートなどのテトラアクリレート類などが挙げ られる。これらは、1種または2種以上を同時に使用し てもよい。

【0032】上記官能基を有さないメタクリル酸エステ ルの具体例としては、メチルメタクリレート、エチルメ タクリレート、n-プロピルメタクリレート、i so-プロピルメタクリレート、ローブチルメタクリレート、 isoーブチルメタクリレート、secーブチルメタク リレート、teェーブチルメタクリレート、アミルメタ クリレート、ヘキシルメタクリレート、ヘプチルメタク リレート、オクチルメタクリレート、ノニルメタクリレ ート、デシルメタクリレート、ドデシルメタクリレー ト、テトラデシルメタクリレート、ヘキサデシルメタク リレート、オクタデシルメタクリレート、シクロヘギシ ルメタクリレート、2ーエチルヘキシルメタクリレー ト、2-メトキシエチルメタクリレート、2-エトキシ エチルメタクリレート、2-メトキシプロピルメタクリ レート、2-エトキシプロピルメタクリレート、ペンジ ルメタクリレート、フェニルカルビトールメタクリレー ト、ノニルフェニルメタクリレート、ノニルフェニルカ ・ルビトールメタクリレート、ジシクロペンテニルオキシ エチルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタク

リレート、イソボルニルメタクリレートなどのモノメタクリレート類;エチレングリコールジメタクリレート、1,3ープチレングリコールジメタクリレート、1,4ープチレングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、1,6ーペキサングリコールジメタクリレート、2,2ービス(4ーメタクリリロールジメタクリレート、2,2ービス(4ーメタクリレート類;トリメチロールエタントリエタクリレートなどのトリメタクリレート類などが挙げられる。これらは、1種または2種以上を同時に使用してもよい。界面活性剤としては、例えば、ノニオン系界面活性剤、アニオン系界面活

性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤などが挙 げられ、さらには、フッ素系界面活性剤、シリコーン系

界面活性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性剤、ポリ (メタ) アクリレート系界面活性剤などを挙げることができ、好ましくはフッ素系界面活性剤、シリコーン系

界面活性剤を挙げることができる。

【0033】フッ素系界面活性剤としては、例えば1, 1, 2, 2-テトラフロロオクチル (1, 1, 2, 2- 20 テトラフロロプロピル) エーテル、1, 1, 2, 2ーテ トラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチレン グリコールジ (1, 1, 2, 2ーテトラフロロブチル) エーテル、ヘキサエチレングリコール(1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エーテル、オクタ プロピレングリコールジ(1, 1, 2, 2ーテトラフロ ロブチル) エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ (1, 1, 2, 2, 3, 3ーヘキサフロロペンチル) エ ーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、 1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10ーデカフ ロロドデカン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロ デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンア ミド) プロピル]-N, N 'ージメチルーNーカルボキ シメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキ ルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、 パーフルオロアルキルーNーエチルスルホニルグリシン 塩、リン酸ビス(Nーパーフルオロオクチルスルホニル ーN-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキ ルエチルリン酸エステル等の末端、主鎖および側鎖の少 なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオ 40 ロアルキレン基を有する化合物からなるフッ案系界面活 性剤を挙げることができる。また、市販品としてはメガ ファックF142D、同F172、同F173、同F1 83(以上、大日本インキ化学工業(株)製)、エフト ップEF301、同303、同352 (新秋田化成 (株) 製)、フロラードFC-430、同FC-431

(住友スリーエム (株) 製)、アサヒガードAG71

O、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-

102、同SC-103、同SC-104、同SC-1

05、同SC-106 (旭硝子 (株) 製)、BM-10

00、BM-1100(裕商(株) 製)、NBX-15 ((株) ネオス)などの名称で市販されているフッ素系 界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上 記メガファックF172, BM-1000, BM-11 00, NBX-15が特に好ましい。シリコーン系界面 活性剤としては、例えばSH7PA、SH21PA、S H30PA、ST94PA(いずれも東レ・ダウコーニ ング・シリコーン(株)製などを用いることが出来る。 これらの中でも、上記SH28PA、SH30PAに相 当する下記一般式(5)で表される重合体が特に好まし

「【0035】さらに本発明の組成物にはコロイド状シリ カまたはコロイド状アルミナをさらに含有していてもよ い。コロイド状シリカとは、例えば、高純度の無水ケイ 酸を前記親水性有機溶媒に分散した分散液であり、通 常、平均粒径が5~30mμ、好ましくは10~20m μ、固形分濃度が10~40重量%程度のものである。 このような、コロイド状シリカとしては、例えば、日産 化学工業(株)製、メタノールシリカゾルおよびイソプ ロパノールシリカゾル;触媒化成工業(株)製、オスカ ルなどが挙げられる。コロイド状アルミナとしては、日 産化学工業(株)製のアルミナゾル520、同100、 同200;川研ファインケミカル(株)製のアルミナク リアーゾル、アルミナゾル10、同132などが挙げら れる。本発明の膜形成用組成物の全固形分濃度は、好ま しくは、2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜 調整される。組成物の全固形分濃度が2~30重量%で あると、金膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性も より優れるものである。本発明の組成物を、シリコンウ エハ、SiO2 ウエハ、SiNウエハなどの基材に蝕 布する際には、スピンコート、浸漬法、ロールコート 法、スプレー法などの登装手段が用いられる。

【0036】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~1.5 nm程度、2回塗りでは厚さ0.1~3 nm程度の塗膜を形成することができる。その後、常温で乾燥するか、あるいは80~600℃程度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥することにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を形成することができる。この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用することが出来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴ

ン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした滅圧下などで行うことができる。このようにして得られる層間 絶縁膜は、絶縁性に優れ、塗布膜の均一性、比誘電率特性、塗膜の低吸湿性に優れることから、LSI、システムLSI、DRAM、SDRAM、RDRAM、D-R DRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜や層間絶縁膜のエッチングストッパー、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁防止膜などの用途に有用である。

#### [0037]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明する。なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。また、実施例中における膜形成用組成物の評価は、次のようにして測定したものである。

## [0038] <u>重量平均分子量(Mw)</u>

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) 法により測定した。

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、加水分 20 解稿合物1gを、100ccのテトラヒドロフランに溶解して調製した。

標準ポリスチレン: 米国プレッシャーケミカル社製の標準ポリスチレンを使用した。

装置:米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマ トグラム(モデル150-C ALC/GPC)

カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M (長さ50cm)

測定温度:40℃ 流速:1cc/分

#### 【0039】比誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で100℃で1 分間、200℃で1分間基板を乾燥し、さらに420℃ の窒素雰囲気のホットプレート中で30分基板を焼成し た。得られた基板上にアルミニウムを蒸着し、比誘電率 評価用基板を作製した。比誘電率は、横川・ヒューレッ トパッカード(株)製のHP16451B電極およびH P4284AプレシジョンLCRメーター用いて、10 k H z における容量値から算出した。

#### 【0040】<u>クラック耐性</u>

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で100℃で1 分間、200℃で1分間基板を乾燥し、さらに420℃ の窒素雰囲気のホットプレート中で30分基板を焼成し た。この際の最終的な塗膜の膜厚は1.2μmとした。 得られた塗膜付き基板を60℃の温水中に1時間浸漬 し、塗膜の外観を35万ルクスの表面観察用ランプで観 察し、下記基準で評価した。

〇;塗膜表面にクラックが認められない。

×:塗膜表面にクラックが認められる。

#### 【0041】塗膜の弾性率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で100℃で1 分間、200℃で1分間蓋板を乾燥し、さらに420℃ の窒素雰囲気のホットプレート中で30分基板を焼成し た。この基板をナノインデンターXP(ナノインスツル メント社製)を用いて連続剛体測定法により弾性率を測 定した。

#### 【0042】 塗膜のCMP耐性

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で100℃で1 分間、200℃で1分間基板を乾燥し、さらに420℃ の窒素雰囲気のホットプレート中で30分基板を焼成し た。得られた塗膜を以下の条件で研磨した。

【0043】スラリー:シリカー過酸化水素系

研磨圧力:300g/cm²

研磨時間:60秒

CMP後の塗膜の外観を35万ルクスの表面観察用ランプで観察し、下記基準で評価した。

:変化無し

×: 塗膜に傷や剝がれが確認される

## 【0044】合成例1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン 77.04g、テトラメトキシシラン 24.05gとテトラキス(アセチルアセトナート)チタン 0.48gを、プロピレングリコールモノブロピルエーテル 290gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を55℃に安定させた。次に、イオン交換水84gを1時間かけて溶液に添加した。その後、55℃で4時間反応させたのち、アセチルアセトン 25gを添加し、さらに30分間反応させ、反応液を室温まで冷却した。50℃で反応液からメタノールと水を含む溶液を149gエパポレーションで除去し、反応液①を得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、8,500であった。

#### 合成例2

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン17.04gとテトラメトキシシラン24.05gを、プロピレングリコールモノメチルエーテル290gに溶解させたのち、スリーワンモーターで慢粋させ、溶液温度を55℃に安定させた。次に、無水マレイン酸1.5gを溶解させたイオン交換水84gを1時間かけて溶液に添加した。その後、55℃で4時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。50℃で反応液からメタノールと水を含む溶液を149gエパポレーションで除去し、反応液②を得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、1,850であった。

50 石英製セパラブルフラスコ中に、エタノール570g、

【0045】合成例3

イオン交換水160gと10%メチルアミン水溶液90gを添加し、液温を50℃に安定させた。次ぎに、メチルトリメトキシシラン14.5gとテトラエトキシシラン20.0gの混合液を1分間かけて溶液に添加した。その後、60℃で2時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。この溶液にプロピレングリコールモノブロピルエーテル200gを添加し、50℃で反応液からメタノール、エタノール、水、メチルアミンとプロピレングリコールモノブロピルエーテルを含む溶液を930gエバポレーションで除去し、反応液③を得た。このよりにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、124.400であった。

【0046】実施例1

合成例1で得られた反応液①100gにNBX-15 0.006gと重量平均分子量約700の末端ヒドロキ シポリジメチルシロキサン0.25g添加し、を0.2μm孔径のテフロン製フィルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。得られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗布した。得られた強膜の比誘電率を評価したところ、2.62と低い値であった。塗膜のクラック耐性を評価したところ、表面にクラックは認められなかった。また、塗膜の弾性率を評価したところ、1GPaと高い値であった。また、塗膜のCMP耐性を評価したところ、表面に偽は認められなかった。

24

表1に示す組成で実施例1と同様にして評価を行った。 評価結果を表1に示す。

[0048]

【表1】

- ~J77 -	ו ניאשבב	O O O O NAME TO THE				
実施	反応被	<b>添加剂</b>	比誘	弹性率	タラック	CMP
<b>9</b> 4		·	電率	(G₽a)	耐性	耐性
1	Θ	NBX-15 0.006g。重量平均分子量約	2.62	5.1	0	0
	100g	700 の末端にいいかりがりかけい	,	1		
		0.25g			ļ	
2	Φ	重量平均分子量約700 の末端い。中	2.59	5.0	0	0
	100g	\$ 95° 1960000 1.0g				
3	Φ	重量平均分子量約 1400 の末端に「。	2.57	5.0	0	0
	100g	+xx 12" H Krotty 3.0g				
4	<b>Ø</b>	SH28 PA 0.006g,重量平均分子量約	2.65	6.3	0	0
	100g	700 の末端ヒドロキシポワジ/テルシロヤサン				
L		1.0g	<u> </u>		<u> </u>	
5	3	重量平均分子量約700の末端い。中沙	2.25	5.0	0	0
1	100g	まり。 <b>分が付け 0.5g</b>		<u> </u>		
6	2	SH28PA 0.006g。重量平均分子量約	2.38	4.3	0	0
	100g	700 の末端とど呼ばりが丹が呼ば				
		1.0g,重量平均分子量約 2000 の				
	1	±* ¶±4Vンク* リ>ル 5.0g		l	<u> </u>	l

## [0049]比較例1

比較合成例1で得られた反応液①のみを使用した以外は、実施例1と同様にして評価を行った。得られた塗膜の比誘電率を評価したところ、2.63と低い値であり、水浸漬後の塗膜クラックとCMP後の表面傷が認められた。

[005'0]

【発明の効果】本発明によれば、アルコキンシランの加水分解物および縮合物もしくはいずれか一方と末端ヒドロキシポリシロキサンを含有する容液を使用することで、低比誘電率、クラック耐性、弾性率、CMP耐性などのバランスに優れた腹形成用組成物(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能である。

#### フロントページの統き

(51) Int.C1.	7 識別記号		F[		デーマコート (参考)
C 0 8 L	83/06		C08L	83/06	•
	83/14	•		83/14	
C 0 9 D	5/25		C 0 9 D	5/25	
HOIL	21/312		H01L	21/312	<b>C</b> .
	21/316			21/316	G
	21/768			21/90	S
(72)発明者	塩田 淳 東京都中央区築地二丁目11番24号 エスアール株式会社内	ジェイ	Fターム(		2 CPO31 CPO51 EEO46 FD316 GQO1 GQO5 5 BAO3 CAO51 CAO61 EAO1
(72) 発明者	山田 欣司 東京都中央区築地二丁目11番24号 エスアール株式会社内	ジェイ		4_J034	EBO3 EBO4 HAO1 HBO3 LB20 B DLO31 DLO71 DLO81 DL161 HA176 HA186 HA236 JA11 JA34 JA37 JA38 JA39 JA40

PCO8

5F033 QQ48 RR21 SS22 SS30 TT03

XX01 XX06 XX17 XX24

5F058 AA02 AA10 ACO3 AD05 AF04

AH02

JB01 JB03 JB09 JB23 JB31 JC25 JC32 JC38 KA04 KA06 KA09 NA04 NA11 NA17 NA21 PA19 PB09 PB11 PC02 PC03